

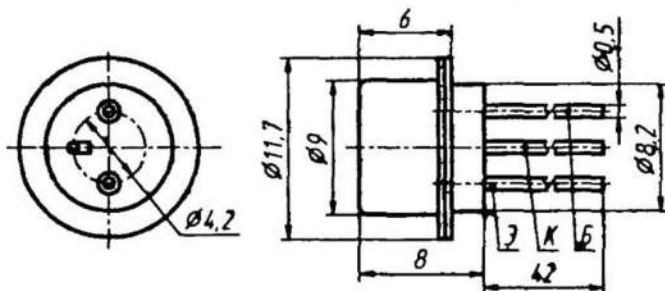
**2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И,
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *п-р-п*. Предназначены для применения в импульсных и переключающих высокочастотных устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1,75 г.

Изготовитель — завод «Транзистор», г. Минск.

2Т603(А-И), КТ603(А-Е)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ:

при $U_{КБ} = 2 \text{ В}$, $I_3 = 150 \text{ мА}$:

2Т603А, 2Т603В, КТ603Д	20...80
КТ603А, КТ603В	10...80
2Т603Б, 2Т603Г	60...180
КТ603Б, КТ603Г, не менее	60
КТ603Е	60...200

при $I_3 = 350 \text{ мА}$ для 2Т603И, не менее

типичное значение

при $T = -60 \text{ }^\circ\text{С}$, $I_3 = 150 \text{ мА}$:

2Т603А, 2Т603В	8...80
2Т603Б, 2Т603Г	20...180
2Т603И, не менее	8

при $T = +125 \text{ }^\circ\text{С}$, $I_3 = 150 \text{ мА}$:

2Т603А, 2Т603В	20...180
2Т603Б, 2Т603Г	60...400
2Т603И, не менее	20

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$, $I_3 = 30 \text{ мА}$,
не менее

типичное значение	200 МГц
	370* МГц

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер:при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, не более	0,8 В
типичное значение	0,2* В
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е, не более	1 В

при $I_K = 350$ мА, $I_B = 50$ мА для 2Т603И,

не менее..... 1,2 В

Напряжение насыщения база—эмиттер:при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е, не более	1,5 В
типичное значение	0,9* В

при $I_K = 350$ мА, $I_B = 50$ мА для 2Т603И,

не более..... 1,3 В

типичное значение 1* В

Время рассасывания при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И, не более.....	70 нс
типичное значение.....	40* нс
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е, не более.....	100 нс

Постоянная времени цепи обратной связи навысокой частоте при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 30$ мА, $f = 5$ МГц, не более..... 400 пс

типичное значение..... 25* пс

Емкость коллекторного переходапри $U_{КБ} = 10$ В, $f = 5$ МГц, не более..... 15 пФ

типичное значение..... 3* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$, $f = 5$ МГц, не более..... 40 пФ

типичное значение..... 35* пФ

Обратный ток коллектора, не более:при $T = +25$ °С и $U_{КБ0} = 30$ В:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	3 мкА
КТ603А, КТ603Б	10 мкА

при $U_{КБ0} = 15$ В:

2Т603В, 2Т603Г	3 мкА
КТ603В, КТ603Г	5 мкА

при $U_{КБ0} = 10$ В для КТ603Д, КТ603Е

при $T = +125$ °С и $U_{КБ0} = 24$ В для

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И 60 мкА

www.eandc.ru ООО компания "Электроника и связь"

при $U_{кб 0} = 12$ В для 2Т603В, 2Т603Г	60 мкА
Обратный ток эмиттера, не более:	
при $U_{кб 0} = 3$ В для 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	3 мкА
при $U_{зэ 0} = 4$ В для 2Т603И	3 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база
и коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 1$ кОм:

$T_n = +70$ °С:

КТ603А, КТ603Б	30 В
КТ603В, КТ603Г	15 В
КТ603Д, КТ603Е	10 В

$T_n = +100$ °С:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	30 В
2Т603В, 2Т603Г	15 В

$T_n = +120$ °С:

КТ603А, КТ603Б	15 В
КТ603В, КТ603Г	7,5 В
КТ603Д, КТ603Е	10 В

$T_n = +125$ °С:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	24 В
2Т603В, 2Т603Г	12 В

$T_n = +150$ °С:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	18 В
2Т603В, 2Т603Г	9 В

Напряжение эмиттер—база:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г	3 В
2Т603И при $T_n = +70$ °С	4 В
2Т603И при $T_n = +125$ °С	3 В

Постоянный ток коллектора
 300 мА |

Импульсный ток коллектора при $t_n \leq 10$ мкс,

$Q = 10$

 600 мА |

Постоянная рассеиваемая мощность:

при $T = +50$ °С

 0,5 Вт |

при $T = +85$ °С для КТ603А, КТ603Б,

КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е и

$T = +125$ °С для 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В,

2Т603Г, 2Т603И

 0,12 Вт |

Тепловое сопротивление переход—среда.....

 200 °С/Вт |

Температура р-п перехода:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И.

 +150 °С |

КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г,

КТ603Д, КТ603Е

 +120 °С |

Температура окружающей среды:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И. $-60...+125$ °С

КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г,

КТ603Д, КТ603Е $-40...+85$ °С

Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода транзистора 3 мм.

Не допускается пайка выводов ближе 5 мм от корпуса. Пайку выводов допускается производить не более 10 с при температуре не более $+270$ °С с теплоотводом между корпусом и местом пайки.

Запрещается кручение выводов вокруг оси.